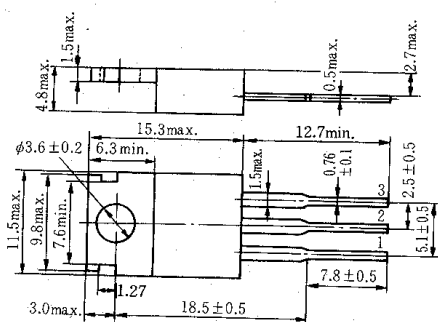


2SD1131, 2SD1132

シリコン NPN 三重拡散形
低周波電力増幅用

SILICON NPN TRIPLE DIFFUSED
LOW FREQUENCY POWER AMPLIFIER



(JEDEC TO-220AB)

1. ベース: Base
 2. コレクタ: Collector
(フランジ) (Flange)
 3. エミッタ: Emitter
- (Dimensions in mm)

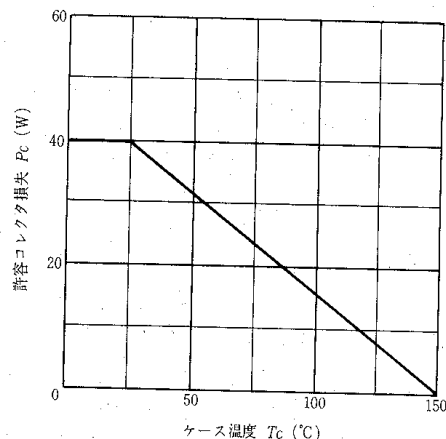
■絶対最大定格 ABSOLUTE MAXIMUM RATINGS ($T_a=25^\circ\text{C}$)

項	目	Symbol	2SD1131	2SD1132	Unit
コレクタ・ベース電圧		V_{CBO}	50	60	V
コレクタ・エミッタ電圧		V_{CEO}	50	60	V
エミッタ・ベース電圧		V_{EBO}	4	4	V
コレクタ電流		I_C	4	4	A
許容コレクタ損失		P_C^*	40	40	W
接合部温度		T_j	150	150	$^\circ\text{C}$
保存温度		T_{stg}	-45~+150	-45~+150	$^\circ\text{C}$

* $T_c=25^\circ\text{C}$ における許容値

* Value at $T_c=25^\circ\text{C}$

許容コレクタ損失のケース温度による変化 MAXIMUM COLLECTOR DISSIPATION CURVE



■電気的特性 ELECTRICAL CHARACTERISTICS ($T_a=25^\circ\text{C}$)

項	目	Symbol	Test Condition	2SD1131			2SD1132			Unit
				min	typ	max	min	typ	max	
コレクタ・ベース破壊電圧		$V_{(BR)CBO}$	$I_C=5\text{mA}, I_E=0$	50	—	—	60	—	—	V
コレクタ・エミッタ破壊電圧		$V_{(BR)CEO}$	$I_C=50\text{mA}, R_{BE}=\infty$	50	—	—	60	—	—	V
エミッタ・ベース破壊電圧		$V_{(BR)EBO}$	$I_E=5\text{mA}, I_C=0$	4	—	—	4	—	—	V
コレクタ遮断電流		I_{CBO}	$V_{CB}=20\text{V}, I_E=0$	—	—	100	—	—	100	μA
直流電流増幅率		h_{FE1}^*	$V_{CE}=4\text{V}, I_C=1\text{A}^{**}$	60	—	320	60	—	320	
直流電流増幅率		h_{FE2}	$V_{CE}=4\text{V}, I_C=0.1\text{A}^{**}$	35	—	—	35	—	—	
ベース・エミッタ電圧		V_{BE}	$V_{CE}=4\text{V}, I_C=1\text{A}^{**}$	—	0.85	1.5	—	0.85	1.5	V
コレクタ・エミッタ飽和電圧		$V_{CE(sat)}$	$I_C=2\text{A}, I_B=0.2\text{A}^{**}$	—	0.5	1.0	—	0.5	1.0	V
利得帯域幅積		f_T	$V_{CE}=4\text{V}, I_C=0.5\text{A}^{**}$	—	8	—	—	8	—	MHz

*2SD1131, 2SD1132は h_{FE1} の値により下記のように3区分し、現品に表示してあります。

*The 2SD1131 and 2SD1132 are grouped by h_{FE1} as follows.

B	C	D
60~120	100~200	160~320

**パルス測定

** Pulse Test